研究報告会13:00~15:00

## 羽田野研究室

## [量子ドットの電気伝導の理論的研究]

生産技術研究所 基礎系部門 <u>Department of Fundamen</u>tal Engineering

http://hatano-lab.iis.u-tokyo.ac.jp

多体系物理学

理学系研究科物理学専攻

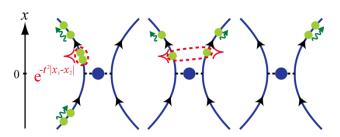
## 量子ドットによるエンタングルメント生成

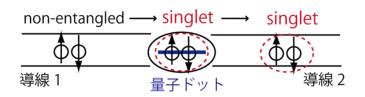
**Entanglement Generation with Quantum Dots** 

- ◆相互作用のある量子ドットの散乱状態を厳密に計算した
- ◆電子が量子ドットを通過すると2体の束縛状態が発生する
- ◆スピン↑とスピン↓が量子ドットを通過するとシングレットが生成される

A. Nishino, T. Imamura, N. Hatano: Phys. Rev. Lett. 102, 146803 (2009);

T. Imamura, A. Nishino, N. Hatano: Phys. Rev. B 80, 245323 (2009).

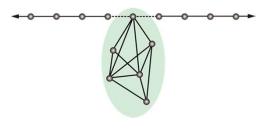




## 共鳴状態による量子ドットのコンダクタンス公式

Conductance Formula of a Quantum Dot based on Resonant States

- ◆一般化されたフレドリクス型量子ドットのコンダクタンスを、共鳴状態や束縛状態 の寄与のみで表した
- ◆ファノ型の非対称コンダクタンスピークが、共鳴状態の干渉で起こることを示した K. Sasada, N. Hatano, G. Ordonez: submitted.



$$G = \frac{e^2}{h} \left[ 1 \pm \sqrt{1 - \left(\frac{\rho_{\text{eigen}}(E)}{\rho_{\text{leads}}(E)}\right)^2} \right]$$

